

深圳市瑞斯特半导体有限公司
Shenzhen RST Semiconductor Co., Ltd.

ELECTRIC DOUBLE LAYER
CAPACITORS
规格书

型号: RST2R7S205DS0812HSP
客户: \
日期: 2026年1月28日

拟定	审核	客户核准
郭石兰	杨友芬	

承认后，请签回一份，在下正式订单前如未签回规格书，视同默认本公司的相关标准及技术指标。

深圳市瑞斯特半导体有限公司

Shenzhen RST Semiconductor Co., Ltd.

1、适用范围

此规格书对产品的性能，测试方法进行了规范，作为技术确认的依据。

2、一般特性

一般情况下，测量及测试的标准大气压条件标准范围如下：

环境温度：15℃~35℃

湿度：25%RH~75%RH

气压：86kPa~106kPa

如对结果有疑问，应按以下条件进行测量：

环境温度：20℃±2℃

湿度：63%RH~67%RH

气压：86kPa~106kPa

3、瑞斯特编码

<u>RST</u>	<u>2R7</u>	<u>S</u>	<u>205</u>	<u>DS</u>	<u>08</u>	<u>12</u>	<u>HSP</u>			
套管颜色 区分	代码	电压 (V)	容量误差		代码	标称 容量 (F)	代码	外径 (mm)	高度 (mm)	系列
瑞斯特 Logo 蓝 底白字	2R7	2.7	R	0%~+20%	105	1	6C	6.3	12.0	HSP
	3R0	3.0	J	±5%	205	2	08	8	16.0	HSD
			V	-10%~+30%	335	3.3	10	10	20.0	
			M	±20%	505	5	1B	12.5	25.0	
			S	-20%~+50%	106	10	16	16	30.0	
				306	30	30	30	62.0		
							35	35	68.0	
				DS	导针型散装					
				GP	盖板排列式					

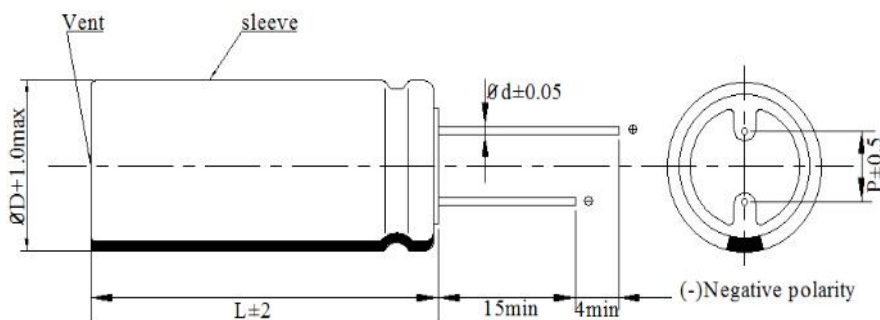
深圳市瑞斯特半导体有限公司

Shenzhen RST Semiconductor Co., Ltd.

4、基本特性

项目	规格	备注
额定电压(U _R)	2.7 V	
标称容量(C)	2 F	
容量偏差	-20%~+50%	
工作温度范围	-40℃~+70℃	
最大等效串联电阻, R _{AC}	≤ 130 mΩ	1kHz
直流内阻, R _{DC}	≤ 800 mΩ	
最大漏电流(72hrs)	0.008 mA	
热电流(25℃)	0.41 A	$I = \frac{C \cdot U}{2(\Delta t + ESR_{DC} \cdot C)}, \Delta t = 5s$
最大峰值电流	1.04 A	$I = \frac{C \cdot U}{2(\Delta t + ESR_{DC} \cdot C)}, \Delta t = 1s$
最大储存能量	0.0020 W.h	$E = \frac{\frac{1}{2}CU^2}{3600}$
能量密度	2.23 Wh/kg	$Ed = \frac{E_{max}}{mass}$
功率密度	1.20 KW/kg	$Pd = \frac{\frac{0.12 \times U_R^2}{R_{DC}}}{mass}$
产品重量 (典型值)	0.91 g	

5、产品尺寸



单位: mm

外形尺寸	
$\phi D(\pm 1.0)$	8.0
$L(\pm 2.0)$	12.0
$\phi d(\pm 0.05)$	0.6
$P(\pm 0.5)$	3.5

深圳市瑞斯特半导体有限公司

Shenzhen RST Semiconductor Co., Ltd.

6、寿命特性

项目		特性
循环寿命	测试方法	在25℃下，用恒定电流使电容器在规格电压和半额定电压间循环充放电。(500,000次)
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的2倍
寿命	贮存寿命	在额定温度上限范围内，无负荷贮存1000小时后电容器符合以下规定的限值。
	耐久性	在额定温度上限范围内，施加额定电压1000小时后，电容器符合以下规定的限值。
	寿命测试	在 +25℃条件下，在额定电压下使用10年后，电容器符合以下规定的限值。
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的2倍
温度特性	测试条件	at -40℃,+25℃,+70℃
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的3倍
湿热特性	测试条件	温度:+40±2℃，湿度:90~95%RH，贮存240小时后，电容器符合以下规定的限值。
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的2倍

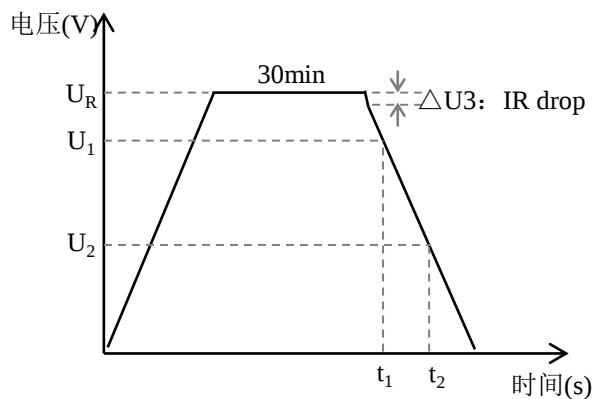
深圳市瑞斯特半导体有限公司

Shenzhen RST Semiconductor Co., Ltd.

7、测试方法

7.1 标称容量

图示:



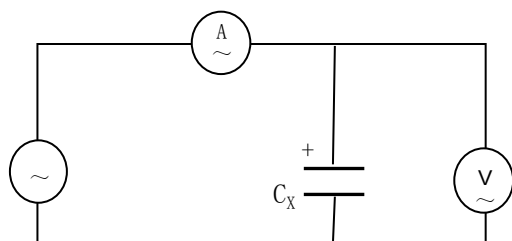
容量计算公式:
$$C = \frac{I \times (t_2 - t_1)}{U_1 - U_2}$$

其中:

- I: 放电电流, $4 \times C \times U_R$ (mA)
- U₁: 测量初始电压, $0.8 \times U_R$ (V);
- U₂: 测量结束电压, $0.4 \times U_R$ (V);
- t₁: 放电开始到测量初始电压U₁的时间(s);
- t₂: 放电开始到测量结束电压U₂的时间(s);

7.2 等效串联电阻

测量电路:



-  振荡器
-  交流电流表
-  交流电压表

内阻计算公式:
$$R_{AC} = \frac{U}{I}$$

其中:

- R_{AC}: 放电电流, $4 \times C \times U_R$ (mA)
- U: 交流电压有效值, (V r.m.s);
- I: 交流电流有效值, (V r.m.s);
- 测量电压的频率: 1kHz;
- 交流电流应为: 1mA~10mA

深圳市瑞斯特半导体有限公司

Shenzhen RST Semiconductor Co., Ltd.

7.3 漏电流

7.3.1 测量开始前，电容器应进行充分放电，放电过程持续1hrs到24hrs；

7.3.2 恒流充电到额定电压，恒压72hrs的漏电流。

7.4 最大峰值电流

1秒钟的最大放电电流：(A)

$$I = \frac{C \cdot U}{2(\Delta t + ESR_{DC} \cdot C)}, \Delta t = 1s$$

7.5 能量和功率

最大储存能量：

$$E_{\max} = \frac{1/2 \times C \times U_R^2}{3600}$$

能量密度：

$$E_d = \frac{E_{\max}}{\text{mass}}$$

功率密度：

$$P_d = \frac{0.12 \times U_R^2}{R_{DC} \cdot \text{mass}}$$

深圳市瑞斯特半导体有限公司

Shenzhen RST Semiconductor Co., Ltd.

8、使用注意事项

- 8.1 超级电容器具有固定的极性。在使用前，应确认极性；
- 8.2 超级电容器应在标称电压下使用：当电容器电压超过标称电压时，将会导致电解液分解，同时电容器会发热，容量下降，而且内阻增加，寿命缩短，在某些情况下，可导致电容器性能崩溃；
- 8.3 超级电容器不可应用于高频率充放电的电路中，高频率的快速充放电会导致电容器内部发热，容量衰减，内阻增加，在某些情况下会导致电容器性能崩溃；
- 8.4 超级电容器的寿命：外界环境温度对于超级电容器的寿命有着重要的影响。电容器应尽量远离热源；
- 8.5 当超级电容器被用做后备电源时，必须考虑其瞬间的电压降：由于超级电容器具有内阻较大的特点，在放电的瞬间存在电压降， $\Delta V = IR$ ；
- 8.6 使用环境：超级电容器不可处于相对湿度大于95%或含有有毒气体的场所，这些环境下会导致引线及电容器壳体腐蚀，导致断路；
- 8.7 超级电容器的存放：超级电容器不能置于高温、高湿的环境中，应在温度 $-40+70^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度小于60%的环境下储存，避免温度骤升骤降，因为这样会导致产品损坏；
- 8.8 超级电容器在双面线路板上的使用：当超级电容器用于双面电路板上，需要注意连接处不可经过电容器可触及的地方，由于超级电容器的安装方式，会导致短路现象；
- 8.9 当把电容器焊接在线路板上时，不可将电容器壳体接触到线路板上，不然焊接物会渗入至电容器穿线孔内，对电容器性能产生影响；
- 8.10 安装超级电容器后，不可强行倾斜或扭动电容器，这样会导致电容器引线松动，导致性能劣化；
- 8.11 在焊接过程中避免使电容器过热：若在焊接中使电容器出现过热现象，会降低电容器的使用寿命，例如：如果使用厚度为1.6mm的印刷线路板，焊接过程应为 260°C ，时间不超过5s；
- 8.12 焊接后的清洗：在电容器经过焊接后，线路板及电容器需要经过清洗，因为某些杂质可能会导致电容器短路；
- 8.13 将电容器串联使用时：当超级电容器进行串联使用时，存在单体间的电压均衡问题，单纯的串联会导致某个或几个单体电容器过压，从而损坏这些电容器，整体性能受到影响，故在电容器进行串联使用时，需得到厂家的技术支持；